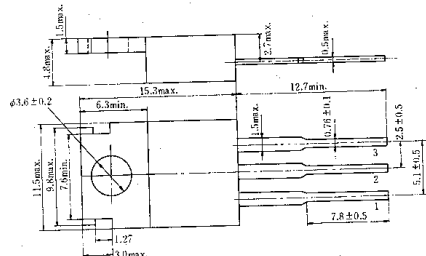


2SC1722

シリコン NPN 三重拡散 LTP 形

低周波電力増幅用
TV 水平、垂直励振用



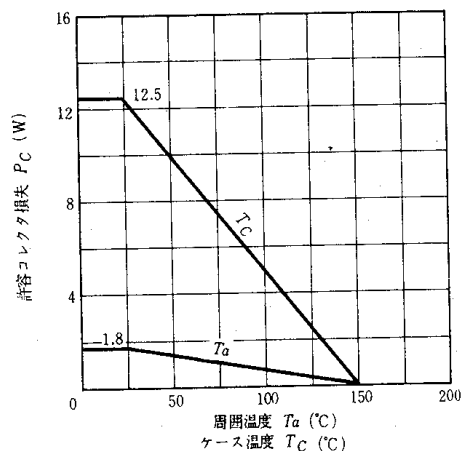
1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector
(フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-220AB)

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED LTP
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
TV HORIZONTAL/VERTICAL DRIV.

許容コレクタ損失の周囲温度、
ケース温度による変化

MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION
CURVE



■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SC1722	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CB0}	300	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CE0}	300	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EB0}	5	V
コレクタ電流		I_C	0.2	A
許容コレクタ損失		P_{C^*}	12.5	W
許容コレクタ損失		P_C	1.8	W
接合部温度		T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値

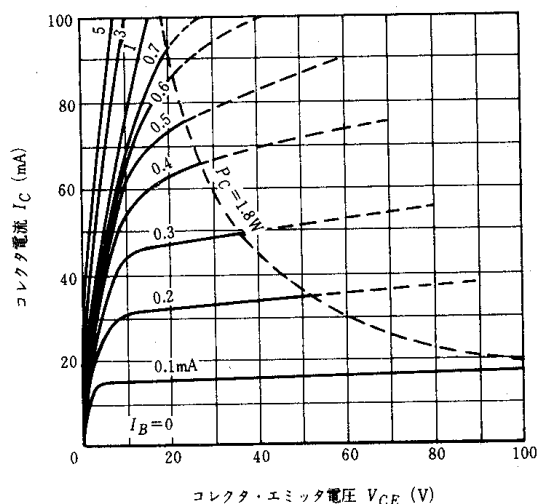
* Value at $T_C=25^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CB0}$	$I_C=100\mu\text{A}$, $I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CE0}$	$I_C=5\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EB0}$	$I_E=100\mu\text{A}$, $I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CB0}	$V_{CB}=250\text{V}$, $I_E=0$	—	—	0.1	μA
		I_{CE0}	$V_{CE}=250\text{V}$, $R_{BE}=\infty$	—	—	2	μA
直流電流増幅率		h_{FE}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$	50	—	300	
コレクタ・エミッタ飽和電圧		$V_{CE(sat)}$	$I_C=50\text{mA}$, $I_B=5\text{mA}$	—	1.0	2.0	V
ベース・エミッタ電圧		V_{BE}	$V_{CE}=10\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$	—	0.68	0.9	V
利得帯域幅積		f_T	$V_{CE}=20\text{V}$, $I_C=30\text{mA}$	—	80	—	MHz
コレクタ出力容量		C_{ob}	$V_{CB}=50\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$	—	4.3	6.0	pF

エミッタ接地出力静特性

TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS



エミッタ接地伝達静特性

TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS

